

26 ноября 2020 г.

Второе информационное сообщение

Глубокоуважаемые коллеги!

Федеральный исследовательский центр «Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук» и Институт физики высоких давлений им.Л.Ф. Верещагина Российской академии наук 26 ноября 2020 г. проводят вторую однодневную конференцию «**Квантовые материалы и технологии на нанометровой шкале**».

Тематика конференции включает в себя следующие основные направления:

- Перспективные наноматериалы и наноструктуры, полученные при высоких давлениях.
- Свойства сильно коррелированных электронных систем на наномасштабах.
- Новые квантовые технологии.
- Полупроводниковые, магнитные, сверхпроводящие наносистемы, в том числе низкоразмерные системы.

Программный комитет

В.В. Бражкин, академик РАН (ИФВД РАН) (со-председатель)
С.В. Демишев, д.ф.-м.н. (ИОФ РАН) (со-председатель)
И.В. Кукушкин, академик РАН (ИФТТ РАН)
В.В. Кведер, академик РАН (ИФТТ РАН)
Н.С. Аверкиев, д.ф.-м.н. (ФТИ РАН)
П.И. Арсеев, чл.-корр. РАН (ФИАН)
В.Н. Рыжов, д.ф.-м.н. (ИФВД РАН)
В.В. Глушков, д.ф.-м.н. (ИОФ РАН)
В.А. Давыдов, д.х.н. (ИФВД РАН)

Оргкомитет

С.В. Демишев, д.ф.-м.н. (ИОФ РАН) (председатель)
В.В. Бражкин, академик РАН (ИФВД РАН)
В.В. Глушков, д.ф.-м.н. (ИОФ РАН)
Е.В. Захарова (ИОФ РАН)
Т.В. Валянская, к.ф.-м.н. (ИФВД РАН)
Л.Б. Солодухина (ИФВД РАН)

На конференции будут заслушаны устные приглашенные доклады (регламент выступления 20-25 мин). Для молодых ученых будет предоставлена возможность принять участие в стендовой сессии, составленной из докладов, отобранных программным комитетом.

Конференция будет проходить в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН (г. Москва, ул. Вавилова, д. 38). Web страница конференции доступна по ссылке:
<https://www.gpi.ru/news/conferences/qmtnano2020conf/>

Для участия в конференции и оформления пропуска для прохода на территорию института необходимо зарегистрироваться, прислав письмо по электронной почте на адрес demis@lt.gpi.ru.

В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество (полностью); название организации; контактную информацию для связи (адрес электронной почты и телефон); характер участия в конференции: приглашенный доклад, стендовый доклад, участник (если планируется участие без доклада).

На указанный в контактной информации адрес электронной почты оргкомитетом будет выслано подтверждение регистрации. Докладчикам необходимо приложить к письму файл тезисов доклада, оформленный в соответствии с прилагаемым образцом. **Учитывая сжатые сроки подготовки программы конференции и сборника тезисов, программный комитет просит участников конференции зарегистрироваться и представить тезисы докладов не позднее 30 октября 2020 г.**

По всем вопросам участия в конференции можно обращаться по электронной почте: demis@lt.gpi.ru (С.В.Демишев) и elena.zakharova.office@gmail.com (Е.В.Захарова).

Список приглашенных докладчиков (предварительный)

А.С. Мельников (Институт физики микроструктур, Нижний Новгород) Топологическая сверхпроводимость.

В.А. Давыдов (ИФВД РАН, Троицк) Низконапряженные наноалмазы с примесно-вакансионными оптическими центрами: синтез, исследование свойств.

Е.А. Екимов (ИФВД РАН, Троицк) Размерно-контролируемый синтез наноалмазов в гетероуглеродородных системах под давлением.

А.В. Цвященко (ИФВД РАН, Троицк) Изучение локальных сверхтонких взаимодействий в сильно коррелированных электронных системах методом возмущенных угловых гамма-гамма корреляций.

С.В.Демишев (ИОФ РАН, Москва). Спин-флуктуационные переходы. Что это такое и где они бывают?

Б.А. Андрюшечкин (ИОФ РАН, Москва). Наноструктурирование поверхности металлов при воздействии галогенов: исследования на атомном уровне.

Н.Е. Случанко (ИОФ РАН, Москва). Динамические зарядовые страйпы в редкоземельных гекса- и додекаборидах.

Е.А. Константинова (МГУ, Москва). Динамика носителей заряда в наноструктурах на основе оксидов титана, молибдена, вольфрама и ванадия.

С.В. Стрельцов (Институт физики металлов РАН, Екатеринбург). Орбитальные степени свободы в физике конденсированного состояния.

Э.В. Девятков (ИФТТ РАН, Черноголовка). Перенос Джозефсоновского тока поверхностными состояниями топологических вейлевских полуметаллов.

К.С. Денисов (ФТИ РАН, Санкт-Петербург). Особенности электронного транспорта в магнитных наногетероструктурах в условиях флуктуаций магнитных скирмионов.

К.А. Барышников (ФТИ РАН, Санкт-Петербург). Магнетосопротивление трехмерных материалов с протяженными дефектами: влияние геометрии магнитного поля и эффектов памяти.

П.В. Петров (ФТИ РАН, Санкт-Петербург). Фаза спиново-зарядового стекла в магнитных и немагнитных полупроводниках. Магнитный фазовый переход под влиянием электростатических флуктуаций.

И.В. Крайнов (ФТИ РАН, Санкт-Петербург). Косвенное обменное взаимодействие в одномерных кристаллах с беспорядком.